

# 2SK532

## シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ( $\pi$ -MOS II)

- 高速大電流スイッチング用
- DC-DC コンバータ用
- モータドライブ用

### 特長

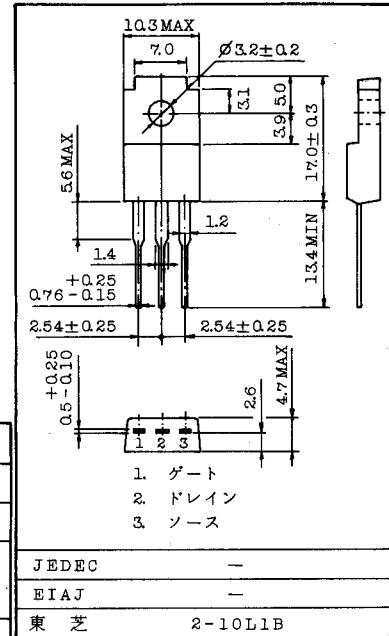
- ・ オン抵抗が低い。:  $R_{DS(ON)} = 0.07\Omega$  (標準)
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。:  $|Y_{fs}| = 5S$  (標準) ( $I_D = 6A$ )
- ・ 漏れ電流が低い。:  $I_{GSS} = \pm 100nA$  (最大) ( $V_{GS} = \pm 20V$ )  
 $I_{DSS} = 1mA$  (最大) ( $V_{DS} = 60V$ )
- ・ 取扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。
- ・ 絶縁プッシング、マイカ等が不要な TO-220 相当のアイソレーションパッケージです。

### 最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DSX}$	60	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GSS}$	$\pm 20$	V
ドレイン電流	DC	$I_D$	12
	パルス	$I_{DP}$	25
許容損失	$P_D$	$T_a = 25^\circ C$	2.0
		$T_c = 25^\circ C$	4.0
チャンネル温度	$T_{ch}$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ 150	$^\circ C$

通信工業用

単位: mm



### 電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位	
ゲート漏れ電流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0$	-	-	$\pm 100$	nA	
ドレインシャ断電流	$I_{DSS}$	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0$	-	-	1.0	mA	
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 10mA, V_{GS} = 0$	60	-	-	V	
ゲートしきい値電圧	$V_{th}$	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$	1.5	-	3.5	V	
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS} = 10V, I_D = 6A$	2	5	-	S	
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D = 6A, V_{GS} = 10V$	-	0.070	0.085	$\Omega$	
ドレイン・ソース間オン電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D = 12A, V_{GS} = 10V$	-	0.9	1.1	V	
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	-	930	1300	pF	
帰還容量	$C_{rss}$	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	-	400	700	pF	
出力容量	$C_{oss}$	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, f = 1MHz$	-	980	1400	pF	
スイッチング時間	上昇時間	$t_r$		-	100	200	ns
	ターンオン時間	$t_{on}$		-	120	240	
	下降時間	$t_f$		-	110	220	
	ターンオフ時間	$t_{off}$		-	190	380	

この製品は MOS 構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。